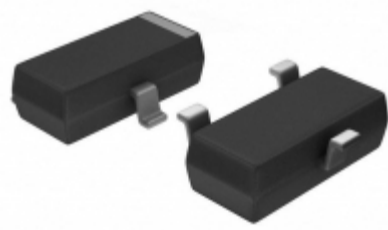
	<h2 style="color: red;">FDN5618P</h2>
	<p>Hersteller-Teilenummer: FDN5618P</p> <p>Hersteller / Marke: AMI Semiconductor / ON Semiconductor</p> <p>Teil der Beschreibung: MOSFET P-CH 60V 1.25A SSOT3</p> <p>Datenblätter: 1.FDN5618P.pdf 2.FDN5618P.pdf</p> <p>RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform</p> <p>Lagerzustand: New original, 127034 pcs Stock Available.</p> <p>Liefern von: Hong Kong</p> <p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

Spezifikationen

Teilenummer	FDN5618P
Hersteller	AMI Semiconductor / ON Semiconductor
Beschreibung	MOSFET P-CH 60V 1.25A SSOT3
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	127034 pcs Stock
Hersteller Standard Vorlaufzeit	42 Weeks
detaillierte Beschreibung	P-Channel 60V 1.25A (Ta) 500mW (Ta) Surface Mount
Serie	PowerTrench®
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Verpackung / Gehäuse	TO-236-3, SC-59, SOT-23-3
Supplier Device-Gehäuse	SuperSOT-3
Verlustleistung (max)	500mW (Ta)
Typ FET	P-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	60V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	1.25A (Ta)
Rds On (Max) @ Id, Vgs	170 mOhm @ 1.25A, 10V
VGS (th) (Max) @ Id	3V @ 250µA
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	13.8nC @ 10V
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	430pF @ 30V
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	4.5V, 10V
Vgs (Max)	±20V
Verpackung	Original-Reel®
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)
Andere Namen	FDN5618PDKR

FDN5618P ist neu im Original, Suche FDN5618P Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie FDN5618P AMI Semiconductor / ON Semiconductor mit Garantie und Vertrauen. Anfrage FDN5618P: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert sein:

 <p>FDN537N Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 30V 6.5A SSOT-3</p>	 <p>FDN5618 FAIRCHILD FAIRCHILD SOT-23</p>	 <p>FDN537N_NL FAIRCHILD FDN537N_NL FAIRCHILD</p>	 <p>FDN5630 Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 60V 1.7A SSOT3</p>
 <p>FDN5618P_G AMI Semiconductor / ON Semiconductor INTEGRATED CIRCUIT</p>	 <p>FDN5618P Fairchild/ON Semiconductor MOSFET P-CH 60V 1.25A SSOT3</p>	 <p>FDN5630-NL FSC FDN5630-NL FSC</p>	 <p>FDN5630 AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 60V 1.7A SSOT3</p>

heiße Teile

Mehr

⚙ FDN355A-NL	➔ FDN355N-NL	➔ FDN356AP-NL	D FDN356P-NL	➔ FDN357N-NL
⚡ FDN357NNL	⚙ FDN357P-NL	D FDN358P-NL	➔ FDN359AN	➔ FDN359AN
⚙ FDN359AN-NL	⚡ FDN359BN	⚙ FDN359BN	➔ FDN359BN	➔ FDN359BN-NL
D FDN359N-NL	⚙ FDN360P-NL	⚡ FDN360P-NL/360	⚙ FDN361AN	➔ FDN361AN
➔ FDN361AN-NL	➔ FDN361BN	⚙ FDN361BN	⚡ FDN361BN-NL	➔ FDN362AN-NL
➔ FDN363N-NL	➔ FDN371N-NL	D FDN372S-NL	⚙ FDN5330SX	⚡ FDN537N-NL
⚙ FDN5618P	D FDN5618P-NL	➔ FDN5630-NL	➔ FDN5630N-NL	➔ FDN5630_NL
⚡ FDN5632-NL	⚙ FDN5632N	➔ FDN5632N-F085	➔ FDN5632N-F085	➔ FDN5632N_F085
⚙ FDN655BN	⚡ FDN8601-NL	⚙ FDN8601N-NL	D FDN86246	➔ FDN86246
➔ FDN86246N-NL	⚙ FDN86265P	⚡ FDN86265P	⚙ FDN86501LZ	➔ FDN86501LZ

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited

